

課題番号 : F-16-IT-0049
利用形態 : 共同研究
利用課題名(日本語) : RTD 発振器の周波数ばらつき測定
Program Title(English) : Measurement of frequency variation in RTD oscillators
利用者名(日本語) : 星沢 拓¹⁾
Username(English) : T. Hoshizawa¹⁾
所属名(日本語) : 1) 株式会社日立製作所
Affiliation(English) : 1) Hitachi, Ltd.

1. 概要(Summary)

テラヘルツ(THz)波の社会実装による、高速無線通信、保安検査、非破壊検査の実現には、小型、低コスト、低消費電力な光源・検出器が必要である。共鳴トンネルダイオード(RTD: Resonant Tunneling Diode)は、常温で最大約 2 THz までの THz 波を発生可能な半導体デバイスであり、各種応用への適用が有望である[1]。上記分野への適用には、単一の RTD 発振器の発振周波数の掃引レンジに、ある程度の幅が必要である。そこで、東京工業大学量子ナノエレクトロニクス研究センターの設備を利用しバラクタ搭載型周波数可変 RTD 発振器の作製を行った。

2. 実験(Experimental)

【利用した主な装置】

電子ビーム露光装置 (スピンコータ・現像装置・ホットプレート・オープン・ドラフトチャンバ等を含む)、電子ビーム露光データ加工ソフトウェア、高真空蒸着装置、触針式段差計、プラズマ CVD 装置、リアクティブイオンエッチング装置、デジタル顕微鏡

【実験方法】

レジスト(PMGI+ ZEP)塗布、電子ビーム露光、現像でマスク形成。金属蒸着(Ti/Pd/Au)後、レジスト除去し、電極形成。ドライエッチング、ウェットエッチングを行い、バラクタメサ・RTD メサを形成した。次に RTD 下部電極を、レジスト塗布、露光、現像、金属蒸着、リフトオフで形成した。プラズマ CVD 装置で SiO₂ 膜を形成し、レジスト塗布、露光、現像した後、リアクティブイオンエッチングで素子分離した。その後、SiO₂パッシベーション膜を形成し、PMMA レジストを塗布、露光、現像、リアクティブイオンエッチングでコンタクトホールを作製。レジスト塗布(PMMA, PMGI, ZEP)、露光、現像、金属蒸着、リフトオフでエアブリッジ接続と MIM 容量を作製した。

3. 結果と考察(Results and Discussion)

作製した 3 個の RTD 発振器の発振周波数特性のば

らつきを調査した結果を Fig.1 に示す。発振周波数の掃引可能レンジはいずれも目標周波数の約 10%程度であった。中心周波数(掃引可能レンジの中心値)は目標周波数に対して約 5%のばらつきがあることを確認した。当該ばらつきの低減が今後の課題である。

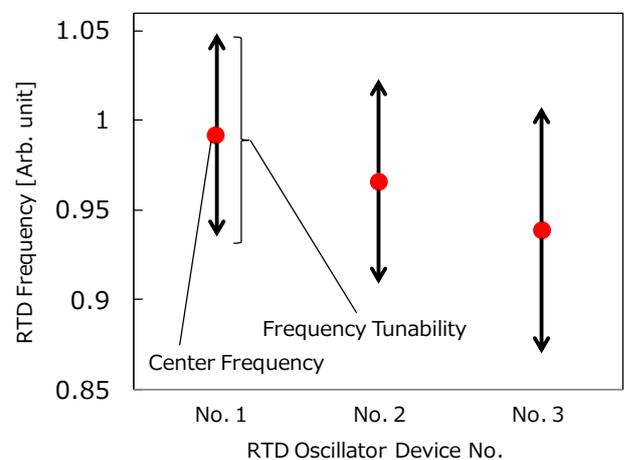


Fig.1 Relation between the bias voltage and the oscillation frequency of the developed RTD oscillator.

4. その他・特記事項(Others)

・参考文献

[1] 浅田雅洋, 鈴木左文, “共鳴トンネルダイオード テラヘルツ波の実用光源への期待”, 応用物理 83, 7, 565-570 (2014).

・支援機関側は浅田雅洋教授, 鈴木左文准教授(東京工業大学)が対応している。

5. 論文・学会発表(Publication/Presentation)

なし。

6. 関連特許(Patent)

なし。